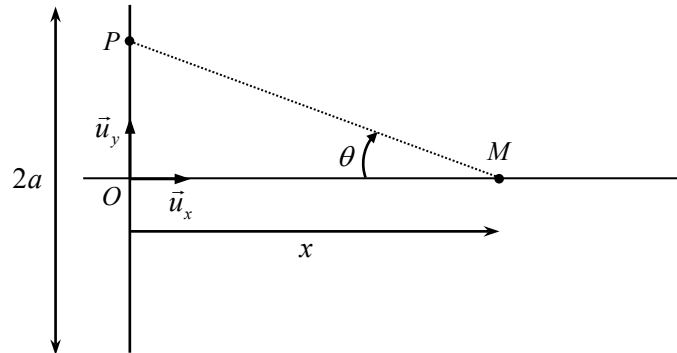


## Thème 3 – Champ créé par une distribution continue de charges

### I- Champ créé par un fil rectiligne

Une charge électrique  $q > 0$  est distribuée uniformément sur un fil de longueur  $2a$  porté par l'axe  $(O, \vec{u}_y)$ , où  $O$  est le centre du fil.



- 1- Quelle est la densité linéique de charge  $\lambda$  portée par le fil ?
- 2- On cherche à exprimer le champ  $\vec{E}(M)$  créé par ce fil en un point  $M$  d'abscisse  $x$  fixée de l'axe  $(O, \vec{u}_x)$ .
  - a- Exprimer le champ électrostatique élémentaire  $d\vec{E}(M)$  créé par l'élément de longueur  $d\ell_p$  entourant le point  $P$  du fil d'ordonnée  $y$ .
  - b- Justifier, en invoquant des arguments de symétrie, que le champ résultant  $\vec{E}(M)$  est orienté selon  $\vec{u}_x$  et donc que seule, la composante  $dE_x = d\vec{E} \cdot \vec{u}_x$  est à considérer pour le calcul du champ total  $\vec{E}(M)$  créé par le fil.
  - c- Exprimer  $dE_x$  en fonction de  $\lambda$ ,  $x$  et de l'angle  $\theta = (\overrightarrow{PM}, \vec{u}_x)$ . En déduire l'expression de  $\vec{E}(M)$  en fonction de  $\lambda$ ,  $x$  et  $a$ .
- 3- Que devient cette expression lorsque  $a \rightarrow +\infty$  ?
- 4- Le fil forme un carré de côté  $2a$  et porte toujours la charge linéique  $\lambda$ . Quelle est la valeur du champ électrique créé par ce carré en son centre ?

### II- Condensateur plan

#### A- Champ créé par un plan infini

On considère un plan infini  $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ , chargé uniformément avec une densité surfacique  $\sigma > 0$ . On repère tout point  $P$  de ce plan par ses coordonnées cylindriques  $(\rho, \theta, z = 0)$  dans le repère  $(O, \vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ .

On cherche l'expression du champ électrostatique  $\vec{E}(M)$  créé en tout point  $M$  de l'axe  $(O, \vec{u}_z)$ , situé au-dessus du plan à l'ordonnée  $z > 0$ , par cette distribution de charges.

- 1- Faire un schéma de la situation on y indiquant en particulier le point  $M$ , le point  $P$  et ses coordonnées, ainsi que les vecteurs de la base cylindrique.
- 2- Soit un élément infinitésimal de surface  $dS_p$  du plan entourant un point  $P$ . Donner les expressions de  $dS_p$  et  $r = PM$  dans le système de coordonnées cylindriques.
- 3- Soit le vecteur unitaire  $\vec{u}_{P/M} = \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|}$ . Donner l'expression de  $\vec{u}_{P/M}$  dans la base cylindrique.
- 4- Rappeler l'expression du champ électrostatique élémentaire  $d\vec{E}(M)$  créé par l'élément de surface  $dS_p$ . Représenter qualitativement  $d\vec{E}(M)$  sur le schéma précédent.

5- Justifier, en invoquant des arguments de symétrie, que le champ résultant  $\vec{E}(M)$  est orienté selon  $\vec{u}_z$  et donc que seule, la composante  $dE_z = d\vec{E} \cdot \vec{u}_z$  est à considérer pour le calcul du champ total  $\vec{E}(M)$  créé par le plan.

6- En déduire que  $\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z$ .

### B- Modèle de condensateur plan

Deux plans de surface  $S$ , considérés comme infinis, chargés uniformément avec les densités surfaciques  $+\sigma > 0$  et  $-\sigma < 0$ , sont situés respectivement en  $z = -d/2$  et  $z = +d/2$ . On note  $P_1$  et  $P_2$  ces deux plans.

1- Faire un schéma de la situation.

2- Donner les expressions des champs  $\vec{E}_1$  et  $\vec{E}_2$  créés par les plans respectivement  $P_1$  et  $P_2$  en  $z < -d/2$ ,  $-d/2 < z < d/2$  et  $z > d/2$ . Représenter qualitativement ces champs sur le schéma précédent.

3- Donner l'expression du champ électrostatique  $\vec{E}(M)$  résultant de la superposition de  $\vec{E}_1$  et  $\vec{E}_2$  en tout point  $M$  de l'espace.

4- Comment varie le potentiel électrostatique  $V(M)$  en tout point  $M$  de l'espace ? Représenter  $V(z)$ . On choisira  $V(z=0) = 0$ . En déduire la différence de potentiel  $\Delta V = V_1 - V_2$  entre les plans  $P_1$  et  $P_2$ .

5- Le système étudié modélise un condensateur plan. Les deux plans de surface  $S$  et distants de  $d$  sont appelés armatures. On définit alors la capacité  $C$  (exprimée en farad F) de ce condensateur comme le rapport entre la charge  $Q$  portée par l'armature inférieure, de densité surfacique  $+\sigma > 0$ , et la différence de

potentiel  $\Delta V$ . Montrer que  $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ .